

# Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Тодуа Павел Андреевич
2	Гражданство	РФ
3	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор физико-математических наук, 01.04.10, ФМ № 003474
4	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор (специальность «Физика полупроводников и диэлектриков», ПР № 018129)
5	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46, <a href="http://www.vniiofi.ru">http://www.vniiofi.ru</a> , E-mail: <a href="mailto:vniiofi@vniiofi.ru">vniiofi@vniiofi.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений
	Ведомственная принадлежность организации	Росстандарт
	Тип организации	ФГУП
	Наименование подразделения	
	Должность	ведущий научный сотрудник
6	Основные публикации в области диссертационного исследования:	
	<p>1. В.П. Гавриленко, А.А. Кузин, А.Ю. Кузин, А.А. Кузьмин, В.Б. Митюхляев, А.В. Раков, П.А. Тодуа, М.Н. Филиппов. Измерение толщины естественного окисла на тестовой рельефной шаговой структуре на подложке из монокристаллического кремния. Микроэлектроника. 2013. Т. 42, № 2. С. 131-133.</p> <p>2. Yu.A. Novikov, V.P. Gavrilenko, Yu.V. Ozerin, A.V. Rakov, P.A. Todua, A.M. Prokhorov. Silicon test object of the linewidth of the nanometer range for SEM and AFM. Proc. of SPIE. 2007. V. 6648. P. 66480R-1-66480R11.</p> <p>3. V.P. Gavrilenko, Yu.A. Novikov, A.V. Rakov, P.A. Todua. Measurement of thickness of native silicon dioxide with a scanning electron microscope. Proc. of SPIE. 2009. V. 7405. P. 740507-1 – 740507-8.</p> <p>4. V.P. Gavrilenko, Yu.A. Novikov, A.V. Rakov, P.A. Todua. Accuracy of ellipsometrie measurements of Si-SiO<sub>2</sub> structures. Proc. of SPIE. 2010. V. 7718. P. 77181B-1-77181B-10.</p> <p>5. Гавриленко В.П., Зайцев С.А., Кузин А.Ю., Новиков Ю.А., Раков А.В., Тодуа П.А. Эллипсометрическая характеристика структур Si—SiO<sub>2</sub>. Нано- и микросистемная техника. 2012. № 2. С. 42-46.</p> <p>6. В.П. Гавриленко, Ю.В. Ларионов, В.Б. Митюхляев, А.В. Раков, М.Н. Филиппов. Измерение размеров элементов нанорельефа тестовой структуры на поверхности кремния методом растровой электронной микроскопии. Микроэлектроника. 2011. № 6. С. 476-480.</p> <p>7. В.П. Гавриленко, А.Ю. Кузин, В.Б. Митюхляев, А.В. Раков, П.А. Тодуа., М.Н. Филиппов, В.А. Шаронов. Влияние контаминации в растровых</p>	

электронных микроскопах на профиль рельефных элементов в монокристаллическом кремнии. Метрология. 2017. № 8. С. 15-23.

8. Заблоцкий А.В., Кузин А.Ю., Михеев Н.Н., Никифорова Н.А., Степович М.А., Тодуа П.А., Филиппов М.Н. Модель квадратичной рекомбинации неосновных носителей заряда в прямозонных полупроводниках для катодолюминесцентной идентификации электрофизических параметров. Нано- и микросистемная техника. 2013. № 6. С. 10-12.

9. В.П. Гавриленко, А.В. Заблоцкий, С.А. Корнейчук, А.Ю. Кузин, Т.А. Куприянова, О.И. Лямина, П.А. Тодуа, М.Н. Филиппов, В.Я. Шкловер. Измерения структурных параметров по эмиссионным рентгеновским спектрам при энергодисперсионной регистрации. Измерительная техника. 2016. № 2. С. 65-67.

7	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
8	Адрес электронной почты